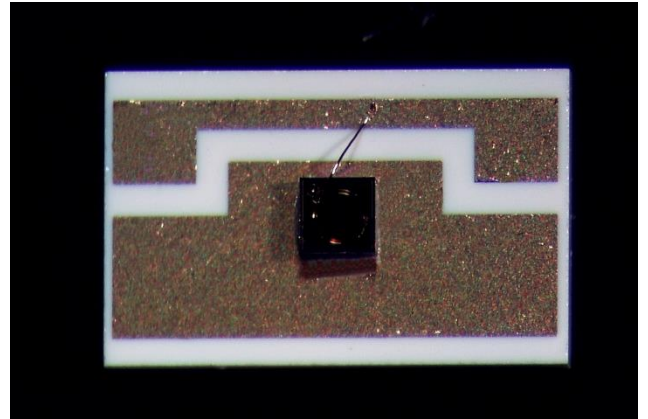


ТФД-CoS InGaAs фотодиод на контактной пластине

ОСОБЕННОСТИ:

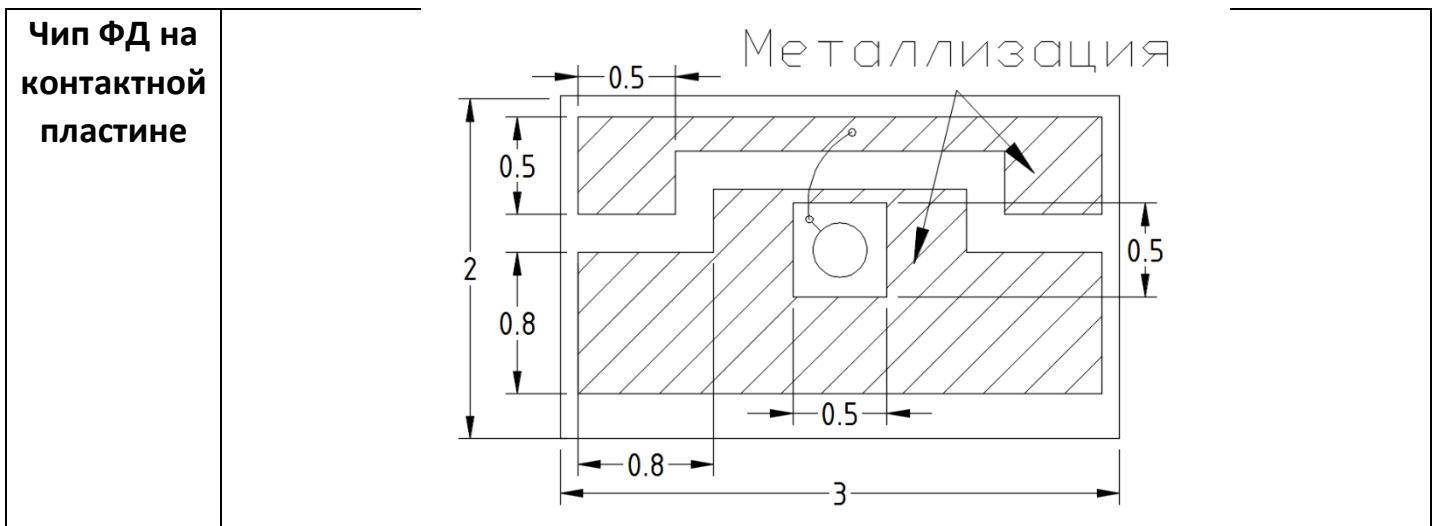
- Чип на контактной пластине
- Низкие ёмкость и темновой ток
- Диаметр приемной площадки 300 мкм



ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Параметр | Символ | мин | тип | макс | Единицы | Условия |
|---------------|-----------|------|-----|------|---------|------------------------------|
| Эффективность | R_D | 0.8 | 0.9 | | А/Вт | $V_R=5$ В, $\lambda=1550$ нм |
| Темновой ток | I_D | | | 5 | нА | $V_R=5$ В, $T=25$ °С |
| Полоса частот | BW | 1.5 | | | ГГц | $V_R=5$ В |
| Ёмкость | C | | 6 | 10 | пФ | $V_R=5$ В, $f=1$ МГц |
| Длина волны | Λ | 1210 | | 1650 | нм | |

Информация для заказа: ТФД-CoS



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

| Параметр | мин | макс | Единицы | Условия |
|----------------------|-----|------|---------|-----------|
| Температура хранения | -10 | 70 | °С | |
| Смена температур | -10 | 70 | °С | |
| Температура пайки | | 200 | °С | 3 секунды |